

## МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ К1624 Общие данные

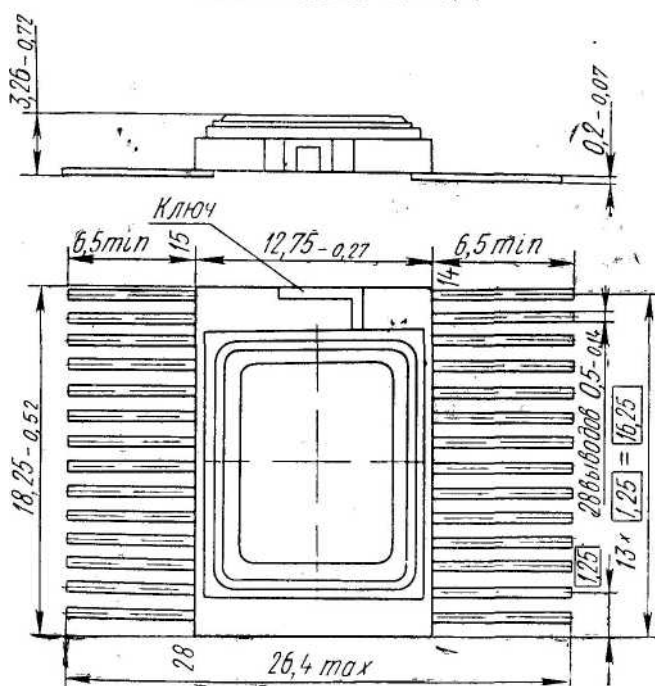
Микросхемы интегральные серии К1624 предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре.

Состав серии К1624

Сокращенное обозначение вида микросхемы	Функциональное назначение	Обозначение документа на поставку
К1624РР1	Постоянное запоминающее устройство с возможностью многократного электрического перепрограммирования	6К0.349.001-01 ТУ

Микросхемы выполнены в прямоугольном корпусе 4119.28-6.01.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Нумерация выводов показана условно.

Масса не более 3 г

### ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц..... 1—2000

амплитуда ускорения,  $m/s^2$  (g) ..... 200 (20)

Механический удар одиночного действия:

пиковое ударное ускорение,  $m/s^2$  (g) ..... 1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс ..... 0,1—2,0

Механический удар многократного действия:

пиковое ударное ускорение,  $m/s^2$  (g) ..... 1500 (150)

длительность действия ударного ускорения, мс ..... 1—5

Линейное ускорение,  $m/s^2$  (g) ..... 5000 (500)

Пониженная рабочая температура среды, °С ..... минус 10

Повышенная рабочая температура среды, °С ..... 70

Изменения температуры среды, °С ..... от минус 60 до +70

### НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка\* ..... 50000

Срок сохраняемости\*, лет ..... 15

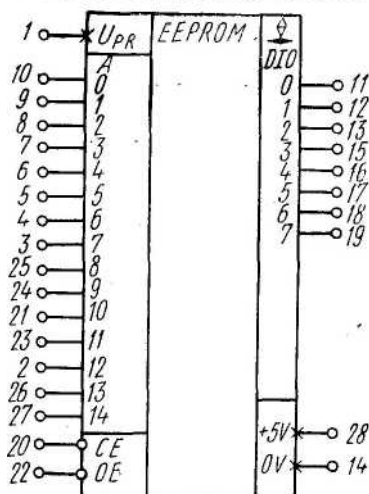
• В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ГОСТ 18725—83 и требованиями, изложенными ниже. Допустимое значение электрического потенциала 200 В.

Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой пайки и паяльником. Температура пайки не более 265°С в течение времени не более 4 с.

### ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



- 1 — напряжение программирования
- 2 — вход двенадцатого разряда адреса  $A_{12}$
- 3 — вход седьмого разряда адреса  $A_7$
- 4 — вход шестого разряда адреса  $A_6$
- 5 — вход пятого разряда адреса  $A_5$
- 6 — вход четвертого разряда адреса  $A_4$
- 7 — вход третьего разряда адреса  $A_3$
- 8 — вход второго разряда адреса  $A_2$
- 9 — вход первого разряда адреса  $A_1$
- 10 — вход нулевого разряда адреса  $A_0$
- 11 — вход/выход нулевого разряда данных  $D_0$
- 12 — вход/выход первого разряда данных  $D_1$
- 13 — вход/выход второго разряда данных  $D_2$
- 14 — общий
- 15 — вход/выход третьего разряда данных  $D_3$
- 16 — вход/выход четвертого разряда данных  $D_4$
- 17 — вход/выход пятого разряда данных  $D_5$
- 18 — вход/выход шестого разряда данных  $D_6$
- 19 — вход/выход седьмого разряда данных  $D_7$
- 20 — вход сигнала разрешения  $CE$
- 21 — вход десятого разряда, адреса  $A_{10}$
- 22 — вход сигнала разрешения выхода  $OE$
- 23 — вход одиннадцатого разряда адреса  $A_{11}$
- 24 — вход девятого разряда адреса  $A_9$
- 25 — вход восьмого разряда адреса  $A_8$
- 26 — вход тринадцатого разряда адреса  $A_{13}$
- 27 — вход четырнадцатого разряда адреса  $A_{14}$
- 28 — 5 В

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (при температуре 25°С)

Напряжение питания, В .....	5+5%
Ток потребления в режиме хранения, мА, не более	20
Динамический ток потребления, мА, не более	80
Ток утечки высокого (низкого) уровня на входах $A_0$ — $A_{14}$ , $CE$ , $OE$ , мкА, не более ....	10
Выходной ток высокого (низкого) уровня в состоянии «выключено», мкА, не более ....	20
Ток сигнала программирования, мА, не более:	
при программировании; при стирании . . .	5
при отсутствии обращения к микросхеме .	2,5
Выходное напряжение высокого уровня, В, не менее	2,4
Выходное напряжение низкого уровня, В, не более	0,4
Время выборки адреса, нс, не более ....	400

Время цикла считывания, нс, не менее . . .	500	
Время выборки разрешения, нс, не менее . . .	400	
Время выборки разрешения выхода, нс, не менее	200	
Время цикла записи информации (байт) в регистр, нс, не менее	1000	
Время программирования страницы, мс, не более	5,5	
Время программирования микросхемы, с, не более	8	
Время стирания информации, с:		
$t_{ERA}$ .....	от 9 до 11	
$t_{ERA1}$ .....	от 19 до 21	
Время хранения информации, ч, не менее:		
при отключенном питании		15 000
при включенном питании в режиме непрерывного считывания		5000
при включенном питании при отсутствии обращения к микросхеме		15000
Количество циклов перепрограммирования, не менее		100
Входная емкость, пФ, не более	5	
Входная емкость сигнала программирования, пФ, не более	8000	
Емкость входа/выхода, пФ, не более . . . . .	12	

### ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение питания, В:		
максимальное .....	5,3	
минимальное .....	4,7	
Напряжение на любом выводе, В:		
максимальное .....	5,3	
минимальное .....	0	
Напряжение сигнала программирования, В:		
максимальное .....	24,5	
минимальное .....	23,5	
Напряжение сигнала программирования при стирании, В:		
максимальное .....	18,4	
минимальное .....	17,6	
Входное напряжение низкого уровня, В:		
максимальное .....	0,6	
минимальное .....	0	
Входное напряжение высокого уровня, В:		
максимальное .....	5,3	
минимальное .....	2,2	
Максимальный выходной ток, мА:		
низкого уровня .....	5,6	
высокого уровня .....	12	
Время программирования страницы, мс:		
максимальное .....	5	
минимальное .....	4	
Время стирания информации, с:		
$t_{ERA}$		
максимальное .....	11	
минимальное .....	6	
$t_{ERA1}$		
максимальное .....	21,5	
минимальное .....	18	
Максимальная емкость нагрузки, пФ . . . . .	50	